PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-066161

(43)Date of publication of application: 06.03.1990

(51)Int.CI.

C23C 14/24

(21)Application number: 62-308426

(71)Applicant:

RES DEV CORP OF JAPAN

HATTORI SHINTARO TAKAHAGI TAKAYUKI

ISHITANI KEI

(22)Date of filing:

04.12.1987

(72)Inventor:

HATTORI SHINTARO TAKAHAGI TAKAYUKI

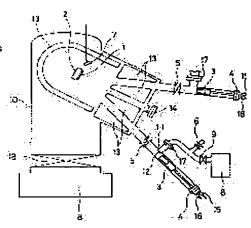
ISHITANI KEI

(54) VACUUM DEPOSITION DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the pyrolysis of a vapor-deposition material and to vapor- deposit a lowmelting-point material by providing a separation mechanism between the substrate and vapordeposition material injection cell in a vacuum vessel, and charging the material into the cell while keeping the substrate in a vacuum.

CONSTITUTION: One or more substrates 1 to be vapor-deposited and one or more injection cells 3 charged with 1 kinds of vapor-deposition material are arranged respectively in the vacuum vessels 10 and 11 provided with a vacuum pump 8 and communicating with each other. The material is heated and vaporized through a heating electrode 15, led toward the substrate 1 from the cell 3 as a molecular beam current, and deposited on the surface. In this vacuum deposition device, a vacuum separation valve 5 is provided between the vessels 10 and 11 to separate the substrate 1 and injection cell 3. The valve 5 is closed, the substrate 1 is kept in a vacuum, a leak valve 6 is opened, and the vapor- deposition material can be charged into the injection cell 3 practically at atmospheric pressure. By this method, the pyrolysis of the material is prevented in baking, and a vapor-deposition material having an m.p. lower than the baking temp. can be used.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-66161

®Int. Cl. 5

識別記号

. 庁内整理番号

四公開 平成2年(1990)3月6日

C 23 C 14/24

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

会発明の名称 真空蒸着装置

> 勿特 顧 昭62-308426

頤 昭62(1987)12月4日 ②出

神 太 郎 個一発明 者 服部

滋賀県大津市大萓5-5-17 ベルメゾン坂口302号室

@ 発明 者 髙 隆 行 获

滋賀県大津市千町2丁目14-10

個発 明 者 石 谷 炯 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 株式会社東レリサーチ センター内

の出 顧 人 新技術開発事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

勿出 願 人 服部 神 太 郎 滋賀県大津市大党5-5-17 ベルメゾン坂口302号室

隆 行 勿出 顋 人 髙 萩

滋賀県大津市千町2丁目14-10

烟 勿出 頭 人 石 谷

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 株式会社東レリサーチ センター内

四代 理 人 弁理士 西澤 利夫

呀

1. 発明の名称

空 58 查

2.特許請求の範囲

真空容器中に1枚もしくは2枚以上の被 蒸着基板と1種もしくは2種以上の蒸着物質が装 填された1個もしくは2個以上の噴出セルとを配 置した蒸着装置において、被蒸着基板と噴出セル との面に1個もしくは2個以上の分離機構を設け、 被悪者基板を真空状態に保持した状態で噴出セル に蒸着物質を実質的に大気圧下で装填可能とした ことを特徴とする真空蒸着装置。

(2) 被素着基板と噴出セルとの間の分離機構 の1個もしくは2個以上が真空バルブである特許 請求の範囲第(1)項記載の真空蒸着装置。

蒸着物質が噴出セルから被蒸着基板に向 けて分子線流を形成する特許額求の範囲第(1) 項記載の真空薫着装置。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、真空蒸着装置に関するものである。 さらに詳しくは、この発明は、熱分解を受けやす い物質、低融点物質を蒸着する場合にも有効に用 いることのできる新しい真空薫着装置に関するも のである.

(背景技術)

無機化合物、有機化合物を問わず分子を基板表 面上に規則正しく配列させ積層した薄膜は、非線 形光学効果や光メモリー、光ー電流変換機能等の バルクの純粋な結晶では見られない新しい機能を 発現するために新たなエレクトロニクス素材とし、 て注目されている。これらの薄膜は、主に真空容 器内に被蔑着基板と共にセットしたヒーター上に 噴出セルに装填した蒸着物質を載せ、このヒータ ーを加熱し蒸着物質を気化させ基板に蒸巻させる 真空薫着法(例えば、稲岡 紀子生ら、表面、2 4 増、61~75ページ、1988年)や超高真空容 器中に被悪着基板と薫着物質を強填した噴出セル

をセットし、吸出セルを加熱し蒸着物質の分子線流を発生させ、この分子線流を被蒸着基板に蒸着する分子線エピタキシー法(MBE法)(例えば、原 正彦、第8回光ファイバー研究会調液会予務為、13~16ページ、1987年7月23日)などにより作製されている。

し、蒸着物質のペーキング操作による熱分解を防止し、あわせてペーキング温度以下の融点を持つ 物質の蒸着をも可能とする新しい真空蒸着装置を 提供することを目的としている。

(発明の開示)

この発明の真空蒸着装置は、上記の目的を実現するために、真空容器中に1枚もしくは2枚以上の被蒸着基板と1種もしくは2種以上の蒸着物質が装填された1個もしくは2個以上の噴出セルとを配置した蒸着装置において、被蒸着基板と噴出セルとの間に1個もしくは2個以上の分離機構を設け、被蒸着基板を真空状態に保持した状態で噴出セルに蒸着物質を実質的に大気圧下で装填可能としたことを特徴としている。

すなわち、この発明の発明者は、真空業者装置に於いて育記の問題点を生じている原因は、被蒸着基板と薫着物質を装填した吸出セルが実質的に同一の真空容器内にあるためと考えた。従って、種々実験検討した結果、蒸着物質を装填した吸出セルを被蒸着基板を収納した装置本体の真空容器

板へ同時に積層することにより分子配列が乱れ、 形成される薄膜の純度や薄膜特有の機能が低下す 。 る問題点があった。

また、熱介解が生じない物質であっても、公知の真空蒸着装置に於いては、融点がベーキング温度以下の物質はベーキング操作中に吸出セル内で激しく沸騰し、気化しない微粒子状態の物質を伴いながら蒸着装置内一面に飛散して吸出セル内がからになるため、融点が低い物質の蒸着が実質的に不可能になる問題点もあった。

さらに、公知の真空蒸着装置では噴出セルへ蒸 着物質を揺充するために、装置全体の真空を破り 真空容器内に空気もしくは窒素、アルゴン、ヘリ ウムなどの気体を導入しなければならない。この ため噴出セルへ蒸着物質を補充する都度、上述し た問題点を含むペーキング操作を新たにやり直す 必要があった。

(発明の目的)

この発明は、以上の通りの事情に差みてなされ たものであり、従来の真空蒸着装置の欠点を改善

とは別個の真空容器に収納し、蒸着物質が噴出セ ルにセットされた状態ではベーキング操作時の熱 が噴出セルが入った真空容器に伝わらないような 構造にすれば解決できることが判明した。また、 装置本体の真空容器と前述の噴出セルを収納した 真空容器との間に真空パルブなどの分離機構を設 置し、被蒸着基板が収的された真空容器の真空を 保持した状態で噴出セルの入った真空容器のみを 大気圧に開放して蒸着物質を補充し、補充後この 部分を再び真空に排気し、再び被薬者基板が収納 された真空容器に結合することにより装置全体の 真空を破らずに蒸着物質を噴出セルに補充できる ことが判明した。この時、噴出セルが入った真空 容器の体積を被蒸着基板を収納した真空容器の体 積より充分小さくしておくことにより暗出セルが 入った真空容器内に吸着した空気や水分等の影響 を無視できることが判った。従ってこれにより被 蒸着基板を収納した真空蒸着装置本体の直空容器 の再度のベーキング操作を実質的に不要にできる ことも判明した。

(3)

この発明は、以上の通りの知見に基づいてなさ れたものである。

設付した図面に沿って次にこの発明の真空蒸着 装置について詳しく説明する。

これに対して、第1回に示したこの発明の一実 値例においては、噴出セル(3)に蒸着物質を装

物質をベーキング操作時の高温に全くさらすことなく真空蒸着を行うことができるので、熱分解を受け易い物質やベーキング温度より低い融点の物質の真空蒸着に好遊であり、特に有機化合物の真空蒸着に適している。

次にこの発明の真空蒸着装置を用いて行った蒸 着の実施例を示し、さらに詳しくこの発明につい て説明する。もちろんこの発明は、以下の実施例 によって限定されるものではない。

例 1

第1図および第2図に示した装置を用い、噴出セル内に蒸着物質として下記の表1に示した化合物(1)~(3)をそれぞれ 0.2 グラム入れ、ベーキング操作的後の融点を測定した。なおベーキング操作は約10~8 Torr、250 ℃、8時間の条件で実施した。また、各化合物の融点はガラス製毛細管に封入した誤料をシリコーン油浴を加熱しながら水銀温度計が示す値を目視で技み取った値である。その結果を表2に示す。

現する前に予め真空蒸着装置全体(10)、

(11)を高温に加熱し真空排気があべーキング操作を施し、その後で容器(10)を真空に保持した設置本体の真空容器(10)を真空に保持した設置では、110を関係を受ける。の真空のでは、110の気がある。では、110の気がある。では、110の気がある。では、110の気がある。では、110のでは、11

第2団は、この場合の噴出セル部の実施例を示 したものである。

以上の例から明らかなように、この発明の真空 蒸着装置においては、上に述べた操作により蒸着

表 1

No.	化学構造式	名称
(1)	NC CN	тсиQ
(2)	CaHe 1- CaHe	シアニン
(3)	H CH-CH-S-S	メロシア ニン色素

表 2

化合物	ペーキング操作的	ベーキング操作後
	の融点	の融点
(1)	287℃	287°C
(2)	272℃	272℃
(3)	270℃	. 270°C

(4)

比較例:1

公知の真空蒸着装置を用いて、噴出セル内に蒸着物質として上記化合物(1)~(3)をそれぞれ0.2 グラム入れ、ベーキング操作的後の融点を認定した。なおベーキング操作条件は例1と同じた。なおベーキング操作を開かると同じた。なおベーキング操作を開かる。そのを表した、各化合物の融点も例1と同じく、ガラス製毛細管に對入した試料をシリコーン油浴に対しながら水銀温度計が最大を目視で読み取った値である。その結果を表3に示す。

表 3

化合物	ベーキング操作的	ベーキング操作後
	の融点	の融点
(1)	287℃	265℃
(2)	272℃	252℃
(3)	270℃	2620

この場合には被塞着物質の熱分解生成物が混入 しているために融点の低下を生じている。

安 5

化合物	ペーキング操作的	ベーキング操作後
	の融点	の融点
(4)	1190	119℃
(5)	200℃	200℃
(6)	218℃	218℃

比較例2

公知の真空蒸着袋置を用いて、吸出セル内に蒸着物質として上配化合物(4)~(6)をそれぞれ 0.2 グラム入れ、ベーキング操作を施した。なおベーキング操作条件は例2 と同じ約10 -8 Tor、250 で、8時間の条件である。この条件下では吸出セル内の蒸着物質が揮発し、全く残存していなかった。

(発明の効果)

以上に示したようにこの発明によれば、真空悪 若装置の噴出セルに入れた悪着物質がベーキング 操作時の高熱の影響を受けないため、熱分解を受けるい物質やベーキング温度より低い融点の物質を容易に真空悪者できる。

贸 2

吸出セル内に蒸着物質として下配化合物(4)~(6)をそれぞれ0.2 グラム入れ、ベーキング操作的投の融点を測定した。なおベーキング操作は約10⁻⁸Torr、250 ℃、8時間の条件で実施した。また、各化合物の融点は例1と同様にして行った。その結果を扱うに示す。

表 4

No.	化学福造式	名 称
(4)	(°×°)	ተ ተ
(5)	O O O O H	キニザリン
(6)		アント ラセン
L		

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明による真空悪者装置の1実 施例を示した断面図である。第2図は、この発明 の真空無着装置の噴出セル部分の1実施例を示し た断面図である。第3図は公知の真空薫着装置の 1例を示した断面図である。

1…被憑着基板、2…基板ホルダー、

3…吸出セル、4…噴出セル取り付けフランジ、

5…真空分離パルブ、6…リークパルブ、

7 … 原厚計、8 … 真空ポンプ、9 … 真空パルプ、

10…真空容器、11…真空容器、

12…じゃま板、13…液体窒素溶、

14…覗き窓、15…噴出セル加熱モーター電極、

16…噴出セル温度開御熱電対電極。

17…真空排気管取り付けフランジ、

18…真空パルプ。

代理人 非理士 西 澤 利 夫

